PTO 892, idem N J

Page 9

Application/Control Number: 10/764,514

Art Unit: 2826

PAT-NO:

JP360012782A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60012782 A

TITLE:

STRUCTURE FOR MOUNTING LIGHT EMITTING DIODE

**PUBN-DATE:** 

January 23, 1985

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

SUGIMOTO, TETSUO

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP58120044

APPL-DATE:

July 1, 1983

INT-CL (IPC): H01L033/00, G02B006/42

, 438/FOR.380

## ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive the access of the light emitting part of an LED to the end surface of an optical fiber by a method wherein the LED chip is mounted by the arrangement of the light emitting surface thereof in opposition to the photo penetration hole of a lead frame, and then the back surface electrode of the chip is connected to the lead frame, which are covered with a transparent resin.

US-CL-CURRENT: 29/827, 257/99, 257/676, 257/E33.066, 438/34, 438/FOR.157

CONSTITUTION: A ring electrode 24 having the light emitting surface 26 of the LED chip 5 is made opposed to the hole 34 of the seat 33 of the lead frame 30 in a lead frame band linked by means of a tie-bar 32, and is then soldered

Application/Control Number: 10/764,514

Art Unit: 2826

to the seat 33, and the back surface <u>electrode</u> 23 is connected 7 to the lead frame 31. <u>Sealing with transparent resin</u> 14 is carried out by including the chip 5, connection 7, and all the tips of the lead frames 30 and 31. The light emission of the LED is released out of the hole 34 to the outer surface 35 of the resin 14. The distance (b) between the lead frame 30 and the outer surface 35 is determined in the minimum value on the basis of the mechanical properties of the resin. This structure enables the access of the light emitting surface 26 to the end surface of the optical fiber in 1.2&sim;1.5mm, thus enhancing the coupling efficiency of the LED with the optical fiber.

Page 10

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭60-12782

50Int. Cl.4 H 01 L 33/00 // G 02 B 6/42 識別記号

庁内整理番号 6666-5F 7529-2H

昭和60年(1985)1月23日 43公開

発明の数 1 . 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## 50発光ダイオード実装構造

0)特

願 昭58-120044

20出 -

願 昭58(1983)7月1日

**加発 明 者 杉本哲夫** 

大阪市此花区島屋1丁目1番3

号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

人 住友電気工業株式会社 の出 願

大阪市東区北浜5丁目15番地

人 弁理士 川瀬茂樹 個代 理

発明の名称

発光ダイオード実装構造

2. 特許請求の範囲

光通し穴 3 4 をチップ取付座 3 3 に設けた第 1 リードフレーム30に、LEDチップ5の発光面 26が第1リードフレーム30の光通し穴34に 対向するようLEDチップ5をマウントし、LE Dチップ5の英面電極23と、第2リードフレー ム31とをワイヤポンディングし、LEDチップ 5、ポンデイングワイヤ7、第1リードフレーム 30、第2リードフレーム31の先端を含むよう 透明樹脂でモールドした事を特徴とする発光ダイ オード実装構造。

発明の詳細な説明

(7) 技術分野

この発明は発光ダイオードの実装構造に関する。 光データリンクに於て、発光累子として発光ダイ オード、レーザダイオードが用いられる。受光素 子はホトダイオード、アパランシエホトダイオー

ドなどが使用される。

発光素子と受光素子の間は、光ファイバによつ て結合される。発光ダイオードは安価で使い易い が、光は前方に広く拡散する。チップ面に立てた 法線となす角をりとすると、光強度の分布は、発 光ダイオードの場合ocs O 分布に近い。レンズで校 るとしても、発光ダイオードチップからレンズに 至るまでの間に側方へそれる光成分もあつて、全 ての発光パワーを発光ダイオードの前方へ取り出 す事ができない。

光データリンクを構成する場合、光ファイバに 効率良く発光ダイオードの光を入射させなければ ならない。光ファイバは多モードファイバで石英 ガラス系の場合コア径が100 μm 程度で広くない。 開口数 N A もあまり大きくない場合が多い。

(イ) 従来技術とその問題点

発光ダイオードは、金属製のケースの中にハー メチックシールするものと、透明樹脂でモールド するものと2つに大別される。

第5図は金属製のケースの中に実装された発光

ダイオードの一部縦断面図である。金属製のケースは、皿型のヘッダ1と、ヘッダ1の上からこれを被蓋するキャップ2とより成る。ヘッダ1には外側からリードピン3、3が挿入され、ガラス層4によつて固定されている。一方のリードピン3はケース内で折曲つており、この上に発光ダイオードチップ(以下LEDチップという)5が接着又はハンダ付してある。

LEDチップ 5 の上面周囲にはリング電極 6 が設けてあり、ポンデイングワイヤ 7 によつてリング電極 6 と他のリードピン 3 とが電気的に接続される。

キャップ 2 の前部閉口にはレンズ 8 が取付けてあり、光を集めて、光ファイバ 9 へ効率良く入射するよう工夫されている。

LEDチップ 5 は発光部 1 0 が表面近くにある。 光ファイバ 9 と LED チップ 5 の間には、キャップ 2 によつで決まるかなりの距離がある。光ファイバ 9 は、外側から順に外被覆 1 1 、補強材 1 2、 な級 1 3 などよりなる。芯線 1 3 はさらに、コア、

を示す。

これは、リードフレーム 3 a , 3 b を有し、リードフレーム 3 a の上に、LEDチップ 5 を固している。リング電極 6 と、他のリードフレーム 3 b とをボンデイングワイヤ 7 で接続する。こうしておいて、選明の樹脂でLEDチップ 5 、ワイヤ 7、リードフレーム 3 a , 3 b の端部などをまとめてモールド 1 4 してある。

光ファイバ9の先端はモールド14の面以上に近づけることができない。モールド14の表面とLEDチップ5の距離 a は、短かければ短い程良い。しかし、これは、ボンディングワイヤ7を含まなければならないので、或る程度以下にする事ができない。

ワイヤボンデイングは電極と金、 AB 線とを超音波で溶着するが、ボンデイング端では、ワイヤと電極面が直角になつていることが多い。 彎曲ワイヤの高さを低くするには、ボンデイング端での曲率半径を小さくすればよいが、そうすると、ボンデイング端で大きい曲げモーメントが発生し、

クラッド、シリコーンプライマリコートなどを含む。光が入射すべきコアの直径は狭く、LEDチップ 5 の発光部 1 0 から、コアを見込む角も小さい。

従つて、LEDチップ5で発光した光の一部分しか光ファイバコアに入射しない。つまり、発光ダイオードと光ファイバの結合効率が低い。

キャップ2を残くして、レンズ8とLEDチップ5を近付ければよいわけである。しかし、キャップ2はポンディングワイヤ7に接触してはならないので、レンズ8とLEDチップ5を近づけるには限界がある。

さらに窓のレンズの厚みもある。

また、窓外面とファイバ婚面もある程度、離さなければならない。ファイバと窓に傷のつくのを避けるためである。

てのように、ファイバ端とLEDチップの間隔 はどうしても広くなつてしまう。

第6図は透明樹脂中にモールドした発光ダイオードの平面図、第7図は第6図中のWーW断面図

ポンデイングが外れやすい。

そこで、ポンデイングワイヤ 7 は或る程度以上の曲率半径を与えなければならない。このため砂曲部の頂点が高くなる。

第5図、第6図に示す、いずれの実装構造も、 LEDチップの光の出射される面にポンデイングがなされており、ワイヤが邪魔になるので、LEDチップ面とケース表面の距離るをかなり広くとらなければならなかつた。

### り) 本発明の課題

発光ダイオードと光ファイバの結合効率を上げるため、発光部と光ファイバ蟷頭をできるだけ接近させる事、これが本発明の課題である。

発光ダイオードは、端面発光形と、面発光形がある。ここでは、端面発光形は対象外である。チップ面に直角な方向へ光がでる面発光形を開始にしている。

## (エ) 発光ダイオード

発光ダイオードは、例えば光道信用発光ダイオードとして、短波長帯の ABG2As 、 長波長帯の

InCaAsP が使いやすさ、量産性の点で、既に広く利用されている。

pn接合部の構造はホモ接合、ダブルヘテロ接合などが知られている。実際に作られるのはダブルヘテロ接合が多い。

n型の拡板の上に、n型クラッド層、活性層、 p型クラッド層、p型層を順にエピタキシャル成 長させる。電流をチップの中央に閉じこめるため、 周辺部にもう一層 p n 逆接合部を作つて、周辺部 には電流が通らないようにする。

第1図は発光ダイオードチップの一例を示す平 面図である。第2図は第1図中の『一『断面図で ある。

n型減板20の上に、活性層21、 P型層22 がエピクキシャル成長法によつて作製される。 これは一般的な構造で、活性層21が、 P ・ n型クラッド層で挟まれたり、多様なパリエーションがある。周辺部は P n 逆接合で、電流が通らないようにして、中央に発光部25ができるようにすることが多い。

ルドする、 ようになつている。

切 実 施 例

第 4 図によつて、リードフレームの例を説明する。これは、第 1 リードフレーム 3 0 と第 2 リードフレーム 3 1 をタイパー 3 2 で結合したものである。実際には、これと同じ単位がタイパーによって、左右に連続しており、この連続帯は巻き取られて、保管、運搬されることが多い。

タイパー32によってつながれたリードフレームの帯は、連続的に送られて、LEDチップを実装してゆくことができる。このような方法は既に公知であり、第6図に示す従来例の発光ダイオードも同様に実装される。モールド後にタイパーは除去される。

第 1 リードフレーム 3 0 にLEDチップ 5 をマウントする。従来のリードフレーム 3 a などと異る点は、チップ取付座 3 3 に、光通し穴 3 4 が穿たれている、という事である。

このようなリードフレーム30を使い、LED

P型暦 2 2 の上には、中央が広く開口したリング電極 2 4 が設けてある。恐板 2 0 の下面には要面電極 2 3 が設けてある。光は、リング電極 2 4 の中央の開口から、チップ面に直角な方向に、外部へ出射される。

発光部 2 5 からリング電極 2 4 の上面までの距離は位かであり、数ミクロン~数十ミクロンである。発光面 2 6 と光ファイバを遠く隔てる要因は、リング電極 2 4 と他のリードフレームを接続するボンディングワイヤにある。

(オ) 本発明の構造

本発明の発光ダイオード実装構造は、

- (1) 光通し穴を設けたリードフレームに、
- (2) LEDチップの発光面がリードフレームの 光通し穴に対向するよう、LEDチップをリ ードフレームにマウントし、
- (3) LEDチップの裏面電極と、もう一方のリ - ドフレームとをワイヤボンデイングし、
- (4) LEDチップ、ボンディングワイヤ、リー ドフレームの先端を含むよう透明樹脂でモー

チップ 5 は、従来とは反対に、発光面を光通し穴3 4 に対応するようリードフレーム 3 0 にマウントする。 要面態極 2 3 の方ではなく、発光面 2 6 のあるリング電極 2 4 に於て、リードフレーム 3 0 のチップ取付座 3 3 にマウントするわけである。

さらに、裏面電極 2 3 とリードフレーム 3 1 とをワイヤボンディングする。リング電極 2 4 とリードフレーム 3 0 とは、導電エポキシ、半田ペーストなどを用いて固着されるので電気的に接続される。

このようにした後、LEDチップ 5、ポンデイングワイヤ 7、リードフレーム 3 0 、3 1 の先端を全て含んで、透明樹脂モールドする。こうして実装された発光ダイオードが第 3 図に示すものである。

LEDチップ 5 の発光面が、リードフレーム 3 0 の光通し穴 3 4 に対向しているから、LEDで発生した光は、光通し穴 3 4 からモールド 1 4 の外表面 3 5 の方向へと出射される。

外表面35とリードフレーム30の上面との距

離りは、モールド14が有する固有の機械的性質によって最小値が与えられるが、0.7~1 mm あれば良い。またリードフレームの厚みは例えば0.5 mm程度である。

そうすると、LEDチップ 5 の 発光面 2 G と、 光ファイバ端面の距離は、 1.2 mm ~ 1.5 mm 程度ま で接近させることができる。

#### (+) 効果

本発明の実装構造は、光通し穴を有するリードフレームにLEDを反対向きにしてマウントしているので、ポンディングワイヤが前面に突出していない。

このため、発光ダイオードと光ファイバを結合する際、発光而と光ファイバ端との距離を短くすることができる。距離が短いので、発光ダイオードと光ファイバの結合効率を高める事ができる。 2 図面の簡単な説明

第1図はLEDチップの一例を示す平面図。 第2図は第1図に於ける』—』断面図。

第3図は本発明の発光ダイオード実装構造を示

- 3 3 …… チップ取付座
- 3 4 …… 光 通 し穴
- 35 …… 外 衰 证.

発 明 者 杉 本 哲 夫特許出願人 住友電気工業株式会社 出願代理人 弁理士 川 緻 茂 關門網 す断面図。

第 4 図は本発明の実装構造に使用されるべきリードフレームの一単位を示す平面図。

第 5 図は金属ケースに実装された従来例の発光 ダイオードの縦断面図。

第 6 図は従来例にかかる透明樹脂モールド型の 発光ダイオードの平面図。

第7図は第6図中のWI-W断面図。

5 .... LED チップ .

7 …… ポンディングワイヤ

20 …… 基 板

2 1 …… 活 性 層

22 ····· p 型 層

2 3 …… 爽 面 電 極

2 4 …… リング電極

25 …… 発 光 部

26 …… 発 光 面

30 …… 第1リードフレーム

3 1 …… 第 2 リードフレーム

32 .... 9 1 11 -





